



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种在p型Ge衬底制备n+/p型超浅结的方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201210495667.4
申请日期:	2012-11-18
专利号:	201210495667.4
第一发明人:	刘洪刚;韩乐;薛百清;孙兵;王盛凯
实施情况:	授权
专利证书号:	201210495667.4
其它备注:	高频高压中心

